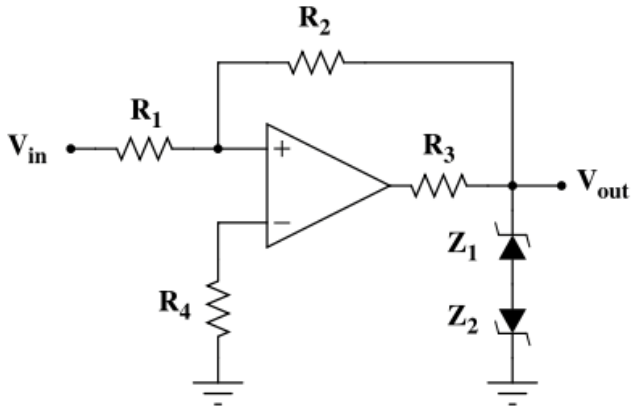


تمرین سری چهارم	درس تکنیک پالس	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
-----------------	----------------	------------------------------------

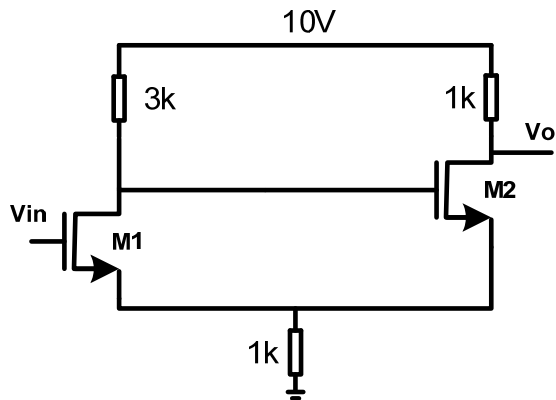
سوال ۱



الف- در مدار اشمیت تریگر شکل مقابل مشخصه خروجی بر حسب ورودی را به دقت محاسبه و رسم کنید.

- $V_{z1}=2V, V_{z2}=5V$
- $V_{dd}=12V, V_{ss}=-12V$
- $R1=20k, R2=30k, R3=1k, R4=1k$

سوال ۲



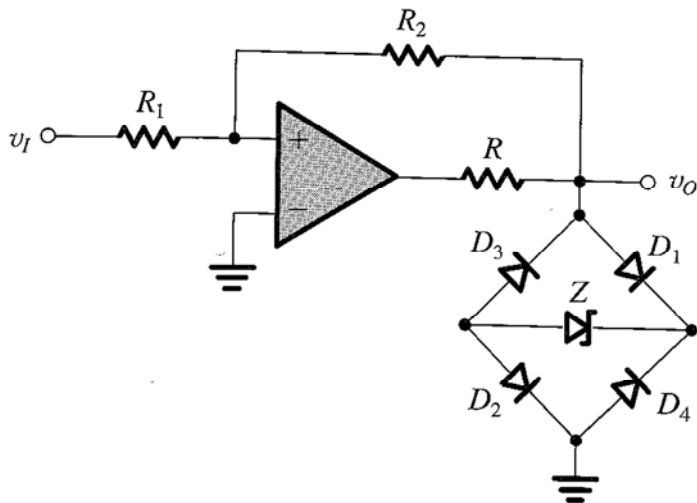
الف- در مدار اشمیت تریگر شکل مقابل مشخصه خروجی بر حسب ورودی را به دقت محاسبه و رسم کنید.

ب- درستی محاسبات فوق را با استفاده از شبیه سازی اسپایس بررسی کنید.

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 96 \frac{mA}{V^2}, \quad V_T = 2V$$

2N6661

سوال ۳

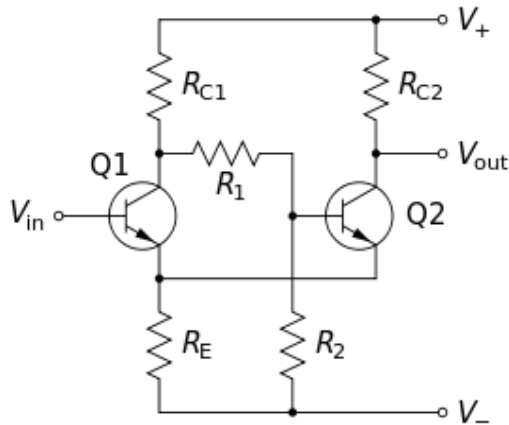


در مدار اشمیت تریگر شکل مقابل مشخصه خروجی بر حسب ورودی را به دقت محاسبه و رسم کنید.

- $V_z=3V$
- $V_{D(on)}=0.7V$
- $V_{dd}=12V, V_{ss}=-12V$
- $R1=40k, R2=100k, R=1k$

سوال ۴

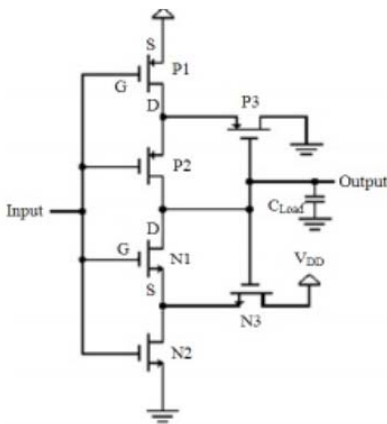
در مدار اشمیت تریگر شکل مقابل مشخصه خروجی بر حسب ورودی را به دقت محاسبه و رسم کنید.



- $V_+ = 8V, V_- = 0V$
- $R_1 = 20k, R_2 = 20k, R_E = 3.2k, R_{C1} = 3.9k$
- $V_{CEsat} = 0.2V, V_{BE(on)} = 0.7V, \beta = 100$

سوال ۵

در مدار اشمیت تریگر شکل مقابل مشخصه خروجی بر حسب ورودی را به دقت محاسبه و رسم کنید.

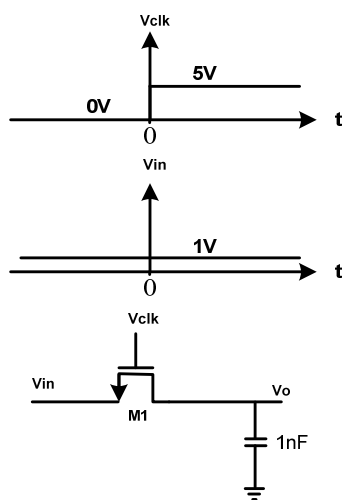


- $V_{DD} = 5V, V_{tn} = -V_{tp} = 0.6V$
- در مورد ترانزیستورهای NMOS داریم:
- $\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 2\left(\frac{W}{L}\right)_3$
- در مورد ترانزیستورهای PMOS داریم:
- $\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 2\left(\frac{W}{L}\right)_3$

سوال ۶

الف- در شکل مقابل یک مدار نمونه گیر^۱ نشان داده شده است. با فرض اینکه $V_C(t=0^-) = 4V$ ، شکل موج خروجی را به دقت رسم کنید. (با تمام جزئیات)

ب- اگر سیگنال ورودی به صورت $v_{in}(t) = 2.5V + 0.5\sin(2\pi f_{in}t)$ باشد و سیگنال فرمان سوئیچ دائما بین صفر ولت و ۵ ولت تغییر کند. با توجه به اینکه عرض باند سوئیچ محدود می باشد، حداکثر فرکانس سیگنال ورودی چقدر می تواند باشد به طوری که در فرآیند نمونه گیری اختلال ایجاد نشود.



$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 4 \frac{mA}{V^2}, \quad V_T = 0.5V$$

¹ Sampler

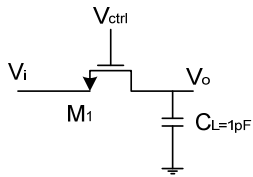
سوال ۷

مدار شکل زیر را در نظر بگیرید. ولتاژ خروجی را قبل و بعد از خاموش شدن ترانزیستور NMOS محاسبه کنید. برای در نظر گرفتن پدیده تزریق بار، فرض کنید که در هنگام خاموش شدن کلیدن الکترون ها به طور مساوی از سورس و درین خارج می شوند. (از حالت های گذرا صرف نظر کرده و جواب را در حالت دائمی بیان کنید)

$$V_o(0^-) = ?$$

$$V_o(+\infty) = ?$$

$$\Delta V_o = V_o(+\infty) - V_o(0^-) = ?$$



$M1$:

$$W = 50 \mu m$$

$$L = 1 \mu m$$

$$C_{ox} = 1.9 \times 10^{-3} \frac{pF}{(\mu m)^2}$$

$$V_m = 0.8V$$

